

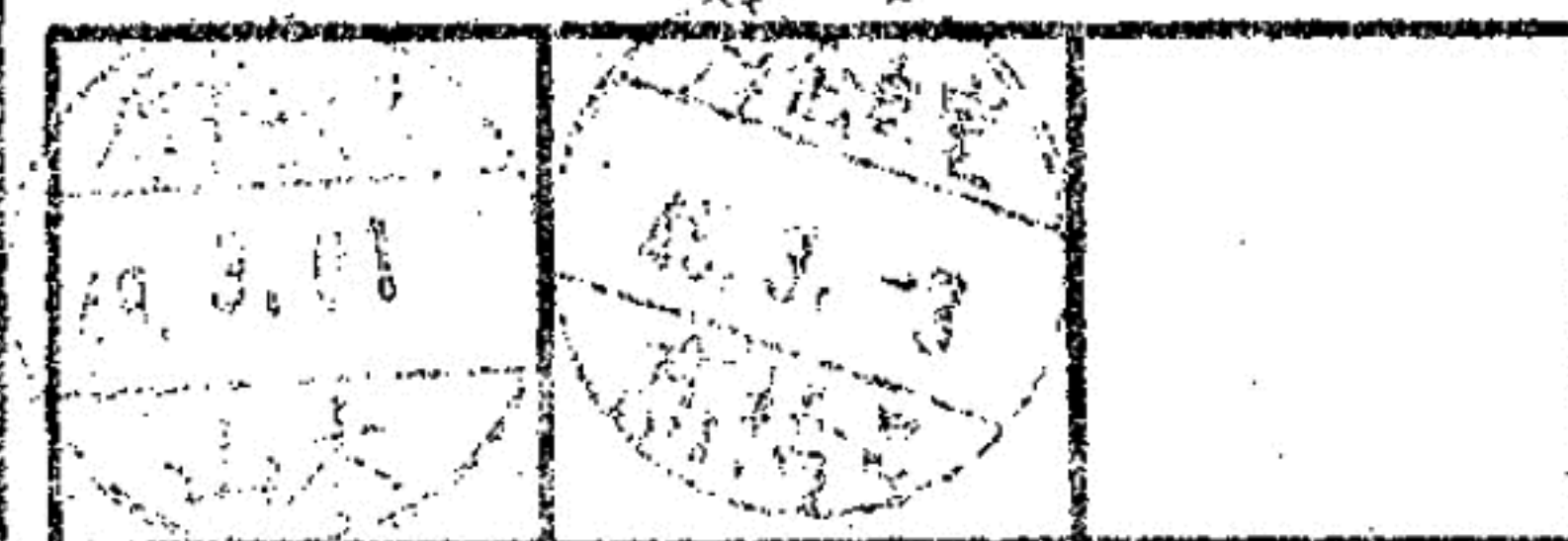
SPECIFICATION TRANSISTORS, DIODES.

NO. 17 - 2T-1323

2 S C 1 4 7 5

PAGE: 2/20/73

暫 定



DATE: / /

1. 構造 NPN・APM形・エピタキシャル・シリコン・トランジスタ
2. 用途 低周波～高周波電力増巾，スイッチング
3. 外形 付図参照

4. 絶対最大定格 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	1.00V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	5.0V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	6V
コレクタ電流	I_C	1A
ベース電流	I_B	0.5A
コレクタ損失	P_C	750mW
ジャンクション温度	T_j	150 $^{\circ}\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-50 $^{\circ}\text{C}$ ～+150 $^{\circ}\text{C}$

5. 電気的特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

項 目	記 号	条 件	最小値	標準値	最大値	単 位
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=25\text{V}, I_E=0$			0.2	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$			0.2	μA
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=5\text{mA}$			0.70	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO(sus)}$	$I_C=2\text{mA}$	50			V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=1\text{A}, I_B=50\text{mA}$			0.3	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$				1.0	V
直流電流増巾率	h_{FE1}	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=100\text{mA}$	98		649	
直流電流増巾率	h_{FE2}	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=1\text{A}$	70			
小信号電流増巾率	$ h_{fe} $	$V_{CB}=2\text{V}, I_E=10\text{mA}, f=10\text{MHz}$		18		dB
コレクタ出力容量	C_C	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0\text{A}, f=1\text{MHz}$		16	40	pF
熱 抵 抗	θ_{j-a}				126	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

DATE

TOSEI CO. INC.

NAME

6. 規格細分

	$h_{FE1} (V_{CE}=2V, I_C=100mA)$	
	最小値	最大値
1	98	156
2	140	222
3	199	316
4	285	451
5	409	649

